

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于实施“5 万片/年 2 英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目” 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 2 月 9 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司实施“5 万片/年 2 英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目”的议案》，同意公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）使用 36,000,000.00 元自有资金实施“5 万片/年 2 英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目”。具体内容如下：

一、投资项目概述

鑫耀公司将在昆明高新技术产业开发区马金铺电力装备园区地块 B-5-5 建设一条 5 万片/年 2 英寸 VGF 磷化铟开盒即用单晶片生产线。项目总投资 3638.68 万元。主要用于改造建筑面积 1711 m²，购置 2 英寸磷化铟晶片生产设备仪器 101 台/套。

二、项目实施主体基本情况

本次项目将由公司控股子公司鑫耀公司负责实施。鑫耀公司基本情况如下：

企业名称：云南鑫耀半导体材料有限公司

统一社会信用代码：915301000776173084

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李苏滨

注册资本：9547 万人民币

成立日期：2013 年 09 月 10 日

营业期限：2013 年 09 月 10 日至长期

住所：云南省昆明市高新区电子工业标准厂房 A 栋 1 楼

经营范围：半导体材料销售；货物及技术进出口业务；半导体生产（限分公司经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有鑫耀公司 70%股权，自然人李苏滨先生持有其 30%股权。

三、资金来源

本次项目实施，鑫耀公司将使用自有资金进行。

四、项目建设的主要内容

1、建设内容

将在昆明高新技术产业开发区马金铺电力装备园区建设一条 5 万片/年 2 英寸 VGF 磷化铟开盒即用单晶片生产线。

2、项目建设期

本项目建设期 12 个月。

3、项目预算

本项目总投资 3638.68 万元，其中固定资产投资 3437.98 万元，流动资金 200.70 万元。

其中，建设投资估算为 3437.98 万元，估算范围包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用等。

4、实施主体

本项目实施主体为鑫耀公司。

五、项目建设可行性

磷化铟（InP）是重要的化合物半导体材料，是继硅（Si）、砷化镓（GaAs）之后的新一代微电子、光电子功能材料。其因电子迁移率高、禁带宽度大等特点，被广泛应用于微波及光电器件领域。磷化铟晶片作为一种新型半绝缘晶片，对于改善和提高基微电子器件的性能具有重要的意义，既保持了传统原生掺铁衬底的高阻特性，同时铁浓度大幅降低，电学性质、均匀性和一致性显著提高，主要用于制作半导体材料以及光纤通信技术。

本项目符合国家产业政策，在中试线成功实施的基础上建设，具有良好的产业化基础。预计本项目建成后每年可实现营业收入 3350 万元，达产年平均利润总额 560 万元（风险提示：以上财务测算是根据当前市场情况测算，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于项目的进展情况、市场状况变化及经营团队努力程度等多种因素）。

六、项目建设对公司的影响

鑫耀公司系本公司控股子公司，目前其已建成砷化镓单晶及晶体产业化生产

线，“5 万片/年 2 英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目”的建设，将进一步丰富其在半导体材料领域的产品，有利于巩固和提升其产业基础，增强其综合竞争力。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日